

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 6 月 21 日 (2007.6.21)

【公表番号】特表 2007-511894 (P2007-511894A)

【公表日】平成 19 年 5 月 10 日 (2007.5.10)

【年通号数】公開・登録公報 2007-017

【出願番号】特願 2006-532518 (P2006-532518)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 37/04 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 1 D

H 0 1 L 21/304 6 4 7 B

H 0 1 L 21/304 6 2 2 P

H 0 1 L 21/304 6 2 2 X

B 2 4 B 37/04 Z

H 0 1 L 21/88 K

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 4 月 25 日 (2007.4.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体ウェハの製造方法であって、

複数の導体配線を備える半導体ウェハの表面を洗浄する処理と、

前記複数の配線は、半導体ウェハの表面に沿って電氣的に絶縁されていることと、

前記半導体ウェハに溶液を適用する処理と、

前記溶液は、界面活性剤及び防食剤を含むと共に、前記半導体ウェハの洗浄処理中又は洗浄処理後に適用されることと、

前記半導体ウェハに前記溶液を適用した後に同半導体ウェハを乾燥する処理と、
を備える方法。

【請求項 2】

半導体ウェハの製造方法であって、

半導体ウェハの C M P 処理を実施することと、

前記半導体ウェハの C M P 洗浄後処理を実施することと、

前記 C M P 処理及び前記 C M P 洗浄後処理の少なくともいずれか一方の処理中に前記半導体ウェハに対する溶液の適用を実施することと、

前記溶液は、溶媒及び共溶媒を含むことと、

を備える方法。

【請求項 3】

半導体ウェハの製造プロセスに用いられる溶液であって、

ポリエチレングリコール (P E G)、ブロック共重合体、又はポリプロピレングリコール (P P G) からなる界面活性剤と、

ベンゼントリアゾール、カフェイン、テオフィリン、ピピリジル、又はトリアゾールか

らなる防食剤と、

水、アルコール、グリコール、アセトン、アセトニトリル、又はプロピレン・カーボネートからなる溶媒と、

前記溶媒とは異なる溶媒であって、アルコール、グリコール、アセトン、アセトニトリル、又はプロピレン・カーボネートからなる共溶媒と、
を含む溶液。

【請求項 4】

半導体ウェハの製造方法であって、

半導体ウェハの C M P 処理を実施することと、

前記半導体ウェハの C M P 処理を実施した後に同半導体ウェハの C M P 洗浄後処理を実施することと、

前記半導体ウェハに溶液を適用することと、
を備え、

前記溶液は、ブロック共重合体、共溶媒、防食剤、及び錯化剤を含む方法。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の方法において、

前記半導体ウェハに対する前記溶液の適用を前記 C M P 洗浄後処理の間に実施する方法
。